

収録範囲	全技術分野		
ファイル種類	特許全文データベース		
特徴	シソーラス アラート (自動 SDI 検索) CAS RN® (CAS 登録番号) <input type="checkbox"/> Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/> 練習用ファイル <input type="checkbox"/>	国際特許分類 (/IPC), 共通特許分類 (/CPC) 毎週 (デフォルト), 毎月 ページイメージ <input type="checkbox"/> 中間一致・ 後方一致検索 <input checked="" type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/>	STN AnaVist <input type="checkbox"/> STN Easy <input type="checkbox"/>
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> 韓国で発行された特許・実用新案の全文情報を収録しています。 公報発行後、約一週間後にデータが収録されます。 各レコードは、書誌情報 (特許出願人, 発明者, 特許情報, 出願情報, 優先権出願情報, 関連出願情報, 国際特許分類, 共通特許分類) と, 標題, 抄録, 詳細な説明, クレームを収録しています。 標題は人手翻訳による英語, 抄録, 発明の詳細な説明, クレームは機械翻訳による英語を収録しています。 標題, 抄録, 発明の詳細な説明, クレーム, 特許出願人, 発明者, 代理人は韓国語で表示できます。 標準化した特許出願人情報を /PAS で, 統制された特許出願人を /PAN で検索できます。 すべての英語の全文テキストフィールドで, 約 20,000 種類の単位で表される 59 の物理学的・化学的物性値が検索可能です。 Key Terms (/KT) を活用すると, 精度と網羅性を重視した検索や, 技術内容の容易な把握が可能です。Key Terms は基本索引 (/BI) に含まれます。 レコードは同一出願単位です。 INPADOCDB ファイルの法的状況, 特許ファミリー, 引用情報を表示できます。 古い年代の一部のデータは, 光学的文字読み取り (OCR) ソフトウェアにより作成されています。そのため, 文字の誤入力やテキストが部分的に不完全な箇所があります。 		
レコード数	4,498,000 件以上 (2020 年 2 月現在)		
収録年代	1978 年以降		
更新頻度	毎週更新		
言語	英語, 韓国語		
データベース	LexisNexis Univentio BV		
製作者	Galileiweg 8 2333 BE Leiden The Netherlands Phone: (+31) 88-6390000 E-mail: customersupport@unuventio.com 著作権保有者		

ヨーロッパ
STN カールスルーエ

 FIZ Karlsruhe
 P.O. Box 2465
 76012 Karlsruhe
 Germany
 Phone: +49-7247-808-555
 Fax: +49-7247-808-259
 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
 Internet: www.stn-international.de
日本
STN 東京
化学情報協会

 〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
 Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
 : 0120-151-462 (上記以外)
 Fax: 03-5978-4090
 E-mail: support@jaici.or.jp(Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
 Internet: www.jaici.or.jp
北アメリカ
STN コロンバス

 CAS
 P.O. Box 3012
 Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
 CAS Customer Care:
 Phone: 800-753-4227 (North America)
 614-447-3700 (worldwide)
 Fax: 614-447-3751
 E-mail: help@cas.org
 Internet: www.cas.org

データベース 代理店	FIZ Karlsruhe STN Europe P. O. Box 2465 76012 Karlsruhe Germany Phone: +49-7247-808-555 Fax: +49-7247-808-259 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de			
収録源	韓国特許庁から発行された公開特許, 登録特許, 実用新案			
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> • 講習会テキスト https://www.jaici.or.jp/stn/text.html • STN 技術資料 https://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html • オンラインヘルプ => HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます • STNGUIDE ファイル 			
利用可能な クラスター	• AEROTECH	• ALLBIB	• AUTHORS	• CORPSOURCE
	• ENGINEERING	• FULLTEXT	• HPATENTS	• NPS
	• PATENTS	• PNTTEXT		

検索フィールド

複数の検索語を AND 演算すると、すべての公報（一つのレコードは出願単位）を対象にそれらの語が検索されます。複数の検索語を (L) 演算すると、特定の公報内の検索に限定することができます。

例えば、S BOREHOLE/AB, TI, CLM (L) KRA/PK で検索すると、KRA 公報内に限定した検索になります。

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはスタリスク (*) で示してあります。

一般検索フィールド

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
なし または /BI	基本索引 * 標題 (/TIEN), 抄録 (/AB), クレーム (/CLM), 詳細な説明 (DETD), 主クレーム (MCLM) (以 上からの切出し語), Key Terms (KT)	S TRANSISTOR AND ELECTRODE S ACOUSTIC SENSOR S ?TRANSFER?	TIEN, AB, ABEN, DETD, CLM, CLMEN, MCLM, MCLEMEN, KT
/AB, /ABEN /AC /AD /AN /AP または /APPS /APO /AY /CLM /CLMEN /CLMN /CPC /CPC. ACD /CPC/KW /CPC. VER /DETN /DT または /TC /DED /DUPD /ED /EDTX /FA /GIS /GIT /IC /ICM または /IPCM /ICS または /IPCS /IN または /AU /IN. CNY /IN. T /IPC /IPC. KW /IPC. REF /IPC. VER また は /IC. VER	抄録 * 出願国 (WIPO コードおよび国名) 出願日 ¹⁾ レコード番号 出願番号 ²⁾ 出願番号, オリジナル 出願年 ¹⁾ クレーム * クレーム (英語) クレームの数 ¹⁾ 共通特許分類 ³⁾ 共通特許分類, 発効日 共通特許分類, キーワード 共通特許分類, 版 詳細な説明のパラグラフ数 ¹⁾ 資料種類 (コードおよびテキスト) データ入力日 ¹⁾ データ更新日 入力日 ¹⁾ 入力日, 全文 ¹⁾ フィールドの存在 図面サイズ 図面タイプ IPC (ICM, ICS), 1-7 版 IPC, 主分類, 1-7 版 IPC, 副分類, 1-7 版 発明者, 発明者, 国 (WIPO コードおよび国名) 発明者, すべて 国際特許分類 ³⁾ (IPCI, IPCR, ICM, ICS) 国際特許分類, キーワード 国際特許分類, 8 版 国際特許分類, 版	S BOREHOLE/AB S KR/AC S AD=JAN 2011 S 599999/AN S KR2012-100038/AP S KR2019760001984/APO S AY>=2005 S DERIVATION/CLM S DERIVATION/CLMEN S 5-7/CLMN S C12N0009/CPC S 20121113/CPC. ACD S C12N0009/CPC (S) I/CPC. KW S 20130101/CPC. VER S 20-30/DETN S PATENT/DT S 20190930-20191031/DED S 20190827/DUPD S ED=DEC 2013 S EDTX>20191130 S ABEN/FA S 200-300/GIS S PNG/GIT S A47J0314-00/IC S B29B0011-14/ICM S B29H0017-30/ICS S PARK A REUM/IN S KR/IN. CNY S MILLER ALFRED/IN. T S A01B0001-16/IPC S INITIAL/IPC. KW S A01B0001-16/IPC. REF S 7/IPC. VER	AB AI AI AN AI APO AI CLM CLM, CLMEN CLMN CPC CPC. TAB CPC. TAB CPC. TAB DETN DT ED DUPD ED EDTX FA GIS GIT IC, ICM, ICS IC, ICM IC, ICS IN IN, IN. CNY IN IPCI, IPCR, ICM, ICS IPC. TAB IPC. TAB IPCI. TAB

(続く)

一般検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内容	入力例	DISPLAY コード
/IPCI	国際特許分類, 発行時	S A47J0314-00/IPCI	IPCI
/IPCR	国際特許分類, 再分類	S B21D0007-08/IPCR	IPCR
/KT	Key Terms	S (LASER(3A)SOURCE?)/KT	KT
/LA	言語 (ISO コードおよび言語名)	S KO/LA	LA
/LAF	出願言語 * (ISO コードおよび言語名)	S KO/LAF	LAF
/MCLM	主クレーム *	S LASER/MCLM	MCLM
/MCLMEN	主クレーム (英語)	S FRACTURE/MCLMEN	MCLMEN, MCLM
/PA	特許出願人 ⁴⁾	S SAMSUNG/PA	PA
または /CS			
/PA. CNY	特許出願人, 国	S KR/PA. CNY	PA, PA. CNY
/PA. T	特許出願人, すべて	S SAMSUNG AEROSPACE IND. CO., LTD. /PA	PA
/PAN	特許出願人, 統制形式	S SAMSUNG/PAN	PAN
/PAS	特許出願人, 標準形式	S SANSUNG AEROSPACE INDUSTRIES/PAS	PAS
/PC	特許国 (WIPO コードおよび国名)	S KR/PC	PI
/PD	発行日 ¹⁾	S 19990108/PRD	PI
/PHP	物性	S PHV/PHP (S) BUFFER/BI	KWIC
/PIT	特許情報, 公報タイプ	S KRA OFFICIAL GAZETTE OF THE UNEXAMINED PATENTS/PIT	PIT
/PK	特許種別コード	S KRA/PK	PI
/PN	特許番号 ²⁾	S KR210004U/PN	PI
または /PATS			
/PNK	種別付き特許番号	S KR210005 Y1/PNK	PI
/PNO	特許番号, オリジナル	S KR300381757/PNO	PNO
/PRC	優先権主張国 (WIPO コードおよび国名)	S KR/PRC	PRN
/PRD	優先権主張日 ¹⁾	S KOREA, REPUBLIC OF/PRC S PRD=MAY, 20 2003	PRN
/PRDF	最先の優先権主張日 ¹⁾	S 20030520/PRD S 20010704/PRDF	PRN
/PRN	優先権主張番号 ²⁾	S AT1982-2545/PRN	PRN
/PRNO	優先権主張番号, オリジナル	S AT0100016/PRNO	PRAO
/PRY	優先権主張年 ¹⁾	S 1999/PRY	PRN
/PRYF	最先の優先権主張年 ¹⁾	S 1999/PRYF	PRN
/PY	発行年 ¹⁾	S 2017/PY	PI
/RLC	関連出願国	S WO/RLC	RLI
/RLD	関連出願日 ¹⁾	S 20120109/RLD	RLI
/RLN	関連出願番号	S WO1982-JP96/RLN	RLI
/RLT	関連出願種別	S PCT APPLICATION/RLT	RLI
/RLY	関連出願年 ¹⁾	S 2017/RLY	RLI
/RLPN	関連特許番号	S WO20000000071/RLPN	RLI
/TI, /TIEN	標題 (英語) *	S LASER/TI	TI, TIEN
/UP	更新日 ¹⁾	S 20191113/UP	UP
/UPTX	更新日, テキスト ¹⁾	S 20191030/UPTX	UPTX

1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) STN 形式またはダウエント形式のどちらでも利用できます。

3) シソーラスが利用できます。

4) このフィールドでは, (S) 演算子はスペースで代用できます。

スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索コードを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスファイルおよびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

SEARCH コード	検索される フィールド	内容	入力例	DISPLAY コード
/APPS	/AP, /PRN	特許出願番号および優先権 出願番号	S KR2012-100038/APPS	AI, PRAI, APPS
/PASS	/PA, /PA.T, /PAS, /PAN	特許出番人グループ	S SAMSUNG/PASS	PA, PAS, PAN, PASS
/PATS	/PN, /RLPN	特許番号グループ	S KR 1399575/PATS	PN, RLPN, PATS

物性検索フィールド¹⁾

PHP フィールドを EXPAND すると、検索可能な物性がわかります。(入力例：=> E TEMP/PHP)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位
/AOS	物質質量	S 10/AOS	mol
/BIR	ビットレート	S 8000-10000/BIR	bit/s
/BIT	保存情報	S BIT>3 MEGABIT	bit
/CAP	静電容量	S 1-10 MF/CAP	F
/CDN	電流密度	S CDN>10 A/M**2	A/m ²
/CMOL	モル濃度	S UREA/BI (S) 8 MOL/L /CMOL	mol/L
/CON	コンダクタンス	S 1S-3/CON	S (Siemens)
/DB	デシベル	S DB>50	dB
/DEG	角度	S CYLINDER/BI (S) 45/DEG	° (degree)
/DEN または /C	密度, 質量濃度	S 5E-3-10E-3/DEN	kg/m ³
/DEQ	線量当量	S 100/DEQ	Sv
/DOS または /LD50	投与量	S DOS>0.8	mg/kg
/DV	動的粘度	S DV>5000	Pa s
/ECH または /CHA	電荷	S 0.0001-0.001/ECH	C
/ECD	電荷密度	S ECD>10	C/m ²
/ECO または /ECND	電気伝導率	S ECO>800 S/M (15A) AQUEOUS	S/m
/ELC	電流	S 1-10/ELC	A
/ELF または /ECF	電場	S 200/ELF	V/m
/ENE	エネルギー	S DROPLETS (10A) 40 JOULE-70 JOULE/ENE	J
/ERE または /ERES	電気抵抗率	S ERE>0.1	Ω m
/FOR	力	S 50 N/FOR	N
/FRE	周波数	S OSCILLAT?/BI (S) 1-3/FRE	Hz
/IU	国際単位	S IU>1000 (P) VITAMIN A	IU
/KV	動粘性率	S LUBRICANT (S) 10E-5/KV	m ² /s
/LEN または /SIZ	長さ	S 1-4/LEN	m
/LUME	照度	S 10-50/LUME	lx
/LUMF	光束	S LUMF>1000	lm

(続く)

物性検索フィールド (続き)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位
/LUMI	光度	S LUMI<4	cd
/M	質量	S ALLOY/BI (30A) 1E-10-1E-5/M	kg
/MCH	質量電荷比	S MCH=1	m/z
/MFD	磁束密度	S MFD>102	T
または /MFS			
/MFR	質量流量	S MFR<0.1	kg/s
または /MFL			
/MM または	モル質量, 分子量	S 2000-3000 G/MOL/MM	g/mol
/MW, /MOM			
/MOLS	質量モル濃度	S 0.1-10 mol/kg/MOLS	mol/kg
/MVR	メルトフローレート	S 3/MVR	g/10min
/NUC または	栄養素含量	S NUC/PHP	g/100kcal
/NUTC			
/PER	パーセント	S POLYMER?/AB (5A) 4/PER	%
/PERA	誘電率	S 1-10/PERA	F/m
/PERR	比誘電率	S 1500-2000/PERR	F/m
/PHV または	水素イオン指数	S 7.4-7.6/PHV	pH
/PH			
/POW または	電力	S (SOLAR? OR PHOTOVOLTAIC?)/BI (10A) 5-10/POW	W
/PW			
/PPM	百万分率	S 100 PPM/PPM (10A) ADDITIVE/BI	ppm
/PRES	圧力	S (VACUUM (5A) DISTILL?)/BI (S) 1000-1100/PRES	Pa
または /P			
/RAD	放射能	S RAD/PHP	Bq
/RES	電気抵抗	S SENSOR/BI (S) 10 OHM - 100 OHM /RES	Ω
/RI	屈折率	S 3-4/RI	-
/RSP	回転速度	S 2 RPM-100 RPM/RSP (S) ENGINE/BI	rpm
/SAR	面積	S PLATE/BI (S) 10 M**2-100 M**2/SAR	m ²
/STSC または /ST	表面張力, ばね定数	S 60 J/M**2/STSC	J/m ²
/TCO または	熱伝導率	S 1/TCO (S) HEAT?	W/m K
/TCND			
/TEMP	温度	S 20-25/TEMP	K
または /T			
/TIM	時間	S ?INCUB?/BI (10A) 50 S-150 S/TIM	s
/VEL	速度	S REDUC?/BI (S) 1E-3-5E-3/VEL	m/s
または /V			
/VELA	角速度	S VELA>10	rad/s
/VLR	体積流量	S 1 M**3/S-2 M**3/S/VLR (S) ABRASIVE	m ³ /s
/VOL	体積	S 1E-8 M**3 - 2E-8 M**3 /VOL. EX	m ³
/VOLT	電圧	S TENSION/BI (10A) 5E- 3V<VOLT<7E-3V	V
/WAC	水分活性	S WAC/PHP	-

1) 指数を用いて検索できます。例：18,000 は 1.8E+4 あるいは 1.8E4, 0.92 は 9.2E-1

国際特許分類 (/IPC) シソーラスの関係コード

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ADVANCED (ADV)	入力した IPC に対応するアドバンスレベルの IPC (SELF, ADVANCED)	E A61K0006-06+ADVANCED/IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (SELF, BT)	E C01F0001-00+BT/IPC
CORE (COR)	入力した IPC に対応するコアレベルの IPC (SELF, CORE)	E G08C0019-22+CORE/IPC
ED	入力語の完全な標題と IPC の版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01B0003-00+HIE/IPC
INDEX	入力語の完全な標題	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXT	次の分類	E C01C0001-00+NEXT/IPC
NEXT (n)	次の n 個の分類コード	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREV	前の分類	E C01C0001-12+PREV/IPC
PREV (n)	前の n 個の分類コード	E C01C0001-12+PREV6/IPC
RT (SIB)	関連語 (BT, SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

旧版 (第 1 版~第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、/IPC に続けて各版の番号を入力します。(例 : /IPC7)

共通特許分類 (/CPC) シソーラスの関係コード

共通特許分類 (/CPC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内容	入力例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E C12M0001-005+ALL/CPC
AUTO ¹⁾	自動関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E CARTRIDGES+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E A01B0001+HIE/CPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01J0003-44+MAX/CPC
NEXT	次の分類	E A01B0001-24+NEXT/CPC
NEXT (n)	次の n 個の分類コード	E A01B0001-24+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/CPC
PREV	前の分類	E G05B0019-00+PREV/CPC
PREV (n)	前の n 個の分類コード	E G05B0019-00+PREV2/CPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/CPC

1) SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND/SEARCH した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。(デフォルトは SET REL OFF)

表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例：=> D L1 1-5 BIB ABS

=> D L1 TI, PA, PI

デフォルトでは、最新の公報の情報のみを表示します。後ろに .M をつけることで、レコード中の全公報の情報を表示することができます。例外的に FA, FAM, CFAM, LS, LS2, RE, SCAN, TRIAL 表示形式では、後ろに .M はつけられません。

特定の種別コードの情報に限定して表示する場合は、表示形式の末尾に . 特許種別コードを付与してください (例：ALL.A)。³⁾ が付与された表示形式で、この入力方法が使えます。

カスタム表示形式

DISPLAY コード	英語名	内容	入力例
AB	Abstract	抄録	D TI AB
ABEN	Abstract (English)	抄録 (英語)	D ABEN
ABKO	Abstract (Korean)	抄録 (韓国語)	D ABKO
AGKO ²⁾	Agent (Korean characters)	代理人 (韓国語)	D AGKO
AI ¹⁾ (AP)	Application Information	出願情報	D AI
AN	Accession Number	レコード番号	D L3 AN
CLM ³⁾	Claims	クレーム	D CLM
CLMEN ³⁾	Claims (English)	クレーム (英語)	D CLMEN
CLMKO	Claims (Korean)	クレーム (韓国語)	D CLMKO
CLMN ²⁾	Number of Claims	クレームの数	D CLMN
CPC	Cooperative Patent Classification	共通特許分類	D CPC
CPC.TAB	CPC, Tabular	共通特許分類 (表形式)	D CPC.TAB
DETDEN ³⁾	Detailed Description (English)	詳細な説明 (英語)	D DETD
DETDKO	Detailed Description (Korean)	詳細な説明 (韓国語)	D DETDKO
DETN ²⁾	Number of Paragraphs in DETD	詳細な説明の段落数	D DETN
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
ED	Entry Date	入力日	D ED
EDTX	Entry Date Full Text	入力日, 全文	D EDTX
FA	Field Availability	フィールドの存在	D FA
GI	Graphic Image	図面	D GI
GIS ²⁾	Graphic Image, Size	図面, サイズ	D GIS
GIT ²⁾	Graphic Image, Type	図面, タイプ	D GIT
IC	IPC(format contains ICM, ICS)	IPC (ICM, ICA含む), 1-7 版	D IC
ICM	IPC, Main	IPC, 主分類, 1-7 版	D ICM
ICS	IPC, Secondary	IPC, 副分類, 1-7 版	D ICS
IN (AU)	Inventor	発明者	D IN
IN.CNY	Inventor, Country	発明者, 国	D IN.CNY
INKO	Inventor (Korean)	発明者 (韓国語)	D INKO
IPCI	IPC, Initial	国際特許分類, 発行時	D IPCI
IPCR	IPC, Reclassified	国際特許分類, 再分類	D IPCR
KT	Key Terms	Key Terms	D KT
LA	Language	言語	D LA
LAF	Language of Filing	出願言語	D LAF
LS ²⁾	Legal Status (from INPADOC database)	法的状況 (INPADOCDB ファイル由来)	D LS
LS2 ²⁾	Legal Status (from INPADOC database), detailed version with display headers	法的状況 (INPADOCDB ファイル由来), 詳細表示	D LS2
MCLM	Main Claim	主クレーム	D MCLM
MCLMEN	Main Claim (English)	主クレーム (英語)	D MCLMEN
MCLMKO	Main Claim (Korean)	主クレーム (韓国語)	D MCLMKO
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人	D PA
PA.CNY	Patent Applicant, Country	特許出願人, 国	D PA.CNY

(続く)

■ カスタム表示形式 (続き)

DISPLAY コード	英語名	内容	入力例
PAKO	Patent Assignee (Korean)	特許出願人 (韓国語)	D PAKO
PAN	Patent Assignee Noemalized	特許出願人, 統制形式	D PAN
PAS	Patent assignee Standardized	特許出願人, 標準形式	D PAS
PI (PN, PATS) ¹⁾	Patent Information	特許情報	D PI
PIT	Patent Information Publication Type	特許情報, 公報タイプ	D PIT
PNO ²⁾	Patent Number, Original	特許情報, オリジナル	D PNO
PRN (PRAI) ^{1), 4)}	Priority Information	優先権情報	D PRN
PRNO (PRAO) ²⁾	Priority Information, Original	優先権情報, オリジナル	D PRNO
RE	Citations (from INPADOCDB)	引用情報 (INPADOCDB ファイル由来)	D RE
RLI (RLN)	Related Patent Information	関連特許情報	D RLI
TIEN	Title (English)	標題 (英語)	D TIEN
TIKO	Title (Korean)	標題 (韓国語)	D TIKO
UP	Update Date	更新日	D UP
UPTX	Update Date Text	更新日, テキスト	

1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。

ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

2) カスタム表示形式でのみ表示可能です。

3) 末尾に .PK (特許種別コード) を付与して表示すると、特定の特許種別コードの情報に限定して表示できます。例：=> D CLM.B1

4) 優先権情報がない場合、出願情報が代わりに収録されます。

■ 定型表示形式

定型表示形式	内容	入力例
ALL ¹⁾	レコードの全情報 (BIB+ABS+IND+CLM+DETD) AN, ED, UP, EDTX, UPTX, DED, DUPD, TIEN, TIKO, IN, PA, PAS, PAN, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI または APO (AIがない場合), RLI, PRAI または PRAO (PRAIがない場合), ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC, ABEN, DETDEN, CLMEN, KT (最新公報の情報)	D ALL
ALLG ¹⁾	ALL, GI	D ALLG
DALL ¹⁾	デリミタ型 ALL 形式	D DALL
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
IALLG ¹⁾	IALL 形式, GI	D IALLG
APPS ¹⁾	AI, RLN, PRAI	D APPS
BIB ¹⁾	書誌情報 AN, ED, EDTX, UP, DED, DUPD, TIEN, TIKO, IN, PA, PAS, PAN, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI (最新公報の情報)	D BIB
BIBG ¹⁾	BIB 形式, GI	D BIBG
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBIB
IBIBG ¹⁾	IBIB 形式, GI	
BIBO ¹⁾	AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, TIKO, IN, INKO, PA, PAS, PAN, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI	D BIBO
BRIEF ¹⁾	書誌情報, 抄録, 主クレーム AN, ED, EDTX, UP, UPTX, DED, DUPD, TIEN, TIKO, IN, PA, PAS, PAN, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC, ABEN, MCLMEN, KT (最新公報の情報)	D BRIEF
IBRIEF ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BRIEF 形式	D IBRIEF
IBRIEFG ¹⁾	IBRIEF 形式, GI	D IBRIEFG
BRIEFO	AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, TIKO, IN, INKO, PA, PAS, PAN, PAKO, AGKO, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC, ABEN, ABKO, MCLMEN, MCLMKO, KT	D BRIEFO

(続く)

定型表示形式 (続き)

定型表示形式	内容	入力例
CFAM ¹⁾	特許ファミリー情報 (特許番号のみ) AN, 特許情報 (特許番号 (INPADOC の情報))	D CFAM
CPC.TAB	共通特許分類の表形式 (最新公報の情報)	D CPC.TAB
FAM ¹⁾	特許ファミリー情報 (特許番号, 出願番号, 優先権出願番号) AN, 特許ファミリー情報 (優先権情報と出願情報の対応表, 出願情報と特許情報の対応表 (INPADOC の情報))	D FAM
IC	国際特許分類 (IPC 1-7 の主分類, 副分類) ICM, ICS (最新公報の情報)	D IC
IND	索引情報 IPC (ICM, ICS, IPCI, IPCR), CPC (最新公報の情報)	D IND
IPC	国際特許分類, 全版 ICM, ICS, IPCI, IPCR (最新公報の情報)	D IPC
IPC.TAB	国際特許分類の表形式 (最新公報の情報)	D IPC.TAB
MAX (ALL.M) ¹⁾	レコードの全情報 (BIB+ABS+IND+CLM+DETD), 全公報の情報 AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, TIKO, IN, PA, PAS, PAN, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC, ABEN, DETDEN, CLMEN, KT, FA	D MAX
MAXG (ALLG.M) ¹⁾	MAX, GI	D MAXG
IMAX (IALL.M) ¹⁾	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
IMAXG (ALLG.M) ¹⁾	IMAX, GI	D IMAXG
MAXO	AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, TIKO, IN, IN.CNY, INKO, PA, PA.CNY, PAS, PAN, PAKO, AGKO, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC, ABEN, ABKO, DETDKO, CLMEN, CLMKO, KT, FA (最新広報の情報)	D MAXO
SCAN ²⁾	回答チェック用表示形式 TI (回答番号なしのランダム表示) (最新公報の情報)	D SCAN
STD ¹⁾ (デフォルト)	書誌情報と特許分類 AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, TIKO, TI, IN, IN.CNY, PA, P A.CNY, LAF, LA, DT, PIT, PI, AI, RLI, PRAI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, CPC (最新公報の情報)	D STD
STDG	STD, GI	D STDG
ISTD ¹⁾	フィールド名付きインデント型 STD 形式	D ISTD
ISTDG ¹⁾	ISTD, GI	D ISTDG
TRIAL (TRI, SAMPLE, SAM, FREE)	回答チェック用表示形式 AN, ED, EDTX, UP, UPTX, TIEN, FA, DETN, CLMN (最新公報の情報)	D TRIAL
TX	全文情報 (詳細な説明, クレーム) DETDEN, CLMEN (最新公報の情報)	D TX
TXO	DETDKO, CLMKO	D TXO

1) 出願番号および特許番号はダウエント形式および STN 形式を利用できます。DISPLAY, PRINT, SELECT および SORT の形式は SET PATENT コマンドにより指定します。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換は => SET PAT DERWENT と入力します。STN 形式に戻す場合には => SET PAT STN と入力します。

2) SCAN 形式は、コマンドに続けて入力します。例: => D SCAN または => DISPLAY SCAN

網がけ はおすすめの定型表示形式です。

ヒットタームに関する表示形式

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。(検索時にハイライト機能を ON にしておく必要があります。)

DISPLAY コード	内容	入力例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語 (最大 50 語) (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

入力例：=> SEL L1 PN (回答セット L1 の回答全件から特許番号を抽出する)

=> ANA L1 1- PA (回答セット L1 の回答全件から出願人を抽出する)

後ろに .M をつけることで、レコード中の全公報の情報を SELECT/ANALYZE することができます (AN, FA 以外)。

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。入力例：=> SORT L1 PD (回答セット L1 の回答全件を発行日の古い順に並び替える)

○ は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード, × は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
AB	抄録	○	○
ABEN	抄録 (英語)	○	○
AC	出願国	○	○
AD	出願日	○	○
AN	レコード番号	○	○
AP (AI)	出願番号	○ ²⁾	○
APPS	出願番号グループ	○	○
APO	出願番号, オリジナル	○	○
AY	出願年	○	○
CLM	クレーム	×	×
CLMN	クレームの数	×	○
CPC	共通特許分類	○	○
DED	データ入力日	○	○
DETD	詳細な説明	×	×
DETN	詳細な説明のパラグラフ数	×	○
DT (TC)	資料種類	○	○
DUPD	データ更新日	○	○
ED	入力日	○	○
EDTX	入力日, 全文	○	○
FA	フィールドの存在	○	×
GIS	図面, サイズ	○	○
IC	IPC (ICM, ICS), 1-7 版	○	×
ICM	IPC, 主分類, 1-7 版	○	○
ICS	IPC, 副分類, 1-7 版	○	○
IN (AU)	発明者	○	○
IN. CNY	発明者, 国	○	○
IPC	国際特許分類	○	○
IPC. A	国際特許分類, アドバンスドレベル	○ ³⁾	×
IPC. AI	国際特許分類, 発明情報のアドバンスドレベル	○ ³⁾	×
IPC. F	国際特許分類, 第一分類 (第 8 版以降)	○ ³⁾	○
IPC. REF	国際特許分類, 8 版	○	×
IPCI	国際特許分類, 発行時	○	○
IPCR	国際特許分類, 再分類	○	○
KT	Key Terms	○	×

(続く)

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内容	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
LA	言語	○	○
LAF	出願言語	○	○
MCLM	主クレーム	×	×
OCC	ヒットタームの出現頻度	×	○
PA (CS)	特許出願人	○	○
PA. CNY	特許出願人, 国	○	○
PAN	特許出願人, 統制形式	○	○
PAS	特許出願人, 標準形式	○	○
PC	特許発行国	○	○
PD	発行日	○	○
PIT	特許情報, 公報タイプ	○	○
PK	特許種別コード	○	○
PN (PI, PATS)	特許番号	○	○
PNK	種別付き特許番号	○	○
PNO	特許番号, オリジナル	○	○
PRC	優先権主張国	○	○
PRD	優先権主張日	○	○
PRDF	最先の優先権主張日	○	○
PRN (PRAI)	優先権主張番号	○	○
PRNO (PRAO)	優先権情報, オリジナル	○	○
PRY	優先権主張年	○	○
PRYF	最先の優先権主張年	○	○
PY	発行年	○	○
RLC	関連特許発行国	○	○
RLD	関連特許発行日	○	○
RLN (RLI)	関連特許番号	○	○
RLT	関連特許種別	○	×
RLY	関連特許発行年	○	○
TI	標題	○	○
TIEN	標題 (英語)	○	○
UP	更新日	○	○
UPTX	更新日, テキスト	○	○

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HIT を使います. 例: => SEL HIT IN

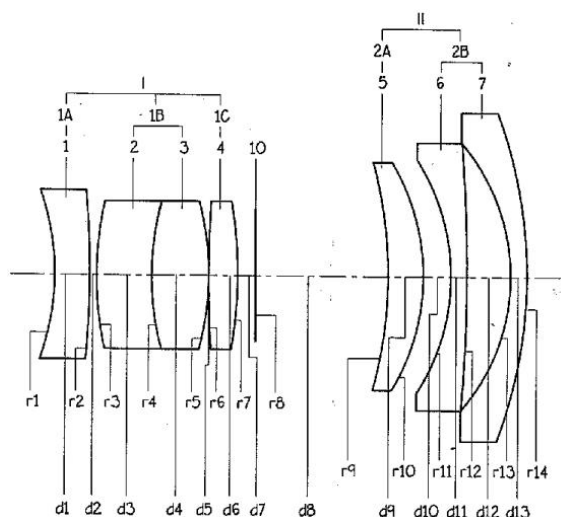
2) AI を用いて SELECT した場合, 抽出されたタームに /AP が付与されます.

3) SELECT で抽出されたタームに /IPC が付与されます.

サンプルレコード

BIBG 表示形式

レコード番号	AN	887596	KRFULL	ED 20191022	UP 20191022	EDTX 20191022
		DUPD 20190806				
標題 (英語)	TIEN	WIDE ANGLE ZOOM LENS OF SMALL SIZE				
標題 (韓国語)	TIKO	소형 광각 줌렌즈				
発明者	IN	KANG, GEON MO, KR				
特許出願人	PA	SAMSUNG TECHWIN CO., LTD., 경상남도 창원시 성주동 28번지, 641120				
特許出願人, 標準形式	PAS	SAMSUNG TECHWIN				
特許出願人, 統制形式	PAN	SAMSUNG				
出願言語	LAF	Korean				
言語	LA	Korean				
資料種類	DT	Patent; (Fulltext)				
特許情報, 公報タイプ	PIT	KRB1 PATENT SPECIFICATION				
特許情報	PI	KR 189064	B1	19990114		
出願情報	AI	KR 1996-36723	19960830			
優先権出願情報	PRAI	KR 1996-36723	19960830			
図面	GI					



ISTD 表示形式

レコード番号	ACCESSION NUMBER:	889200	KRFULL
入力日	ENTRY DATE:	20191022	
更新日	UPDATE DATE:	20191022	
入力日, 全文	ENTRY DATE (FULLTEXT):	20191022	
データ入力日	DATA ENTRY DATE:	20120208	
データ更新日	DATA UPDATE DATE:	20190516	
標題 (英語)	TITLE (ENGLISH):	Device tool for etching silicon wafer	
標題 (韓国語)	TITLE (KOREAN):	자동 색온도 조절 장치	
特許出願人	PATENT APPLICANT(S):	SAMSUNG AEROSPACE IND	
特許出願人, 標準形式	PATENT APPL. STANDARD.:	SAMSUNG AEROSPACE INDUSTRIES	
特許出願人, 統制形式	PATENT APPL. NORMAL.:	SAMSUNG	
出願言語	LANGUAGE OF FILING:	Korean	
言語	LANGUAGE OF PUBL.:	Korean	
資料種類	DOCUMENT TYPE:	Patent; (Fulltext)	
特許情報, 公報タイプ	PATENT INFORMATION TYPE:	KRA OFFICIAL GAZETTE OF THE UNEXAMINED PATENTS	
特許情報	PATENT INFORMATION:	KR 98017371	A 19980605
出願情報	APPLICATION INFO.:	KR 1996-37147	A 19960830
優先権出願情報	PRIORITY INFO.:	KR 1996-37147	19960830
国際特許分類	INT. PATENT CLASSIF.:		
主分類, 1-7 版	MAIN:	H04N0009-07	
国際特許分類, 発行時	IPC ORIGINAL:	H04N0009-07 [I, A]	

BRIEFO 表示形式

レポート番号	AN	3744609 KRFULL ED 20191022 UP 20191022 EDTX 20191022 DED 20151009 DUPD 20181113 Full-text
標題 (英語)	TIEN	Apparatus for cutting an electrode using laser and electrode supply method of the same
標題 (韓国語)	TIKO	레이저를 이용한 전극 커팅 장치 및 그 전극 공급 방법
發明者	IN	MIN, KI HONG, KR; AHN, CHANG BUM, KR; YANG, YOUNG JOO, KR
發明者 (韓国語)	INKO	민기홍, 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, KR 안창범, 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, KR 양영주, 대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원 내, KR
特許出願人	PA	LG CHEM. LTD., 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동), 07336
特許出願人 (韓国語)	PAKO	주식회사 엘지화학, 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동), KR
特許出願人, 標準形式	PAS	LG CHEM
特許出願人, 統制形式	PAN	LG
代理人 (韓国語)	AGKO	특허법인태평양
出願言語	LAF	Korean
言語	LA	Korean
資料種類	DT	Patent
特許情報, 広報タイプ	PIT	KRA OFFICIAL GAZETTE OF THE UNEXAMINED PATENTS
特許情報	PI	KR 2015102771 A 20150908
出願情報	AI	KR 2013-129785 20131030
優先権出願情報	PRAI	KR 2013-129785 20131030
国際特許分類, 再分類	IPCR	B23K0026-10 [I,A]; B23K0026-38 [I,A]; B23K0026-70 [I,A]
共通特許分類	CPC	B23K0037-04; B23K0026-38; B23K0026-083; B23K0026-142; B23K2101-40
抄録 (英語)	ABEN	An apparatus for cutting an electrode using a laser is disclosed. According to an embodiment of the present invention, the apparatus for cutting an electrode using a laser comprises: a laser cutter for irradiating a laser beam; a transfer gripper which transfers an electrode sheet to a position to be irradiated with a laser beam and fixates the electrode sheet during the irradiation of the laser beam; and a rear gripper which transfers a unit electrode body cut by the laser beam and fixates the electrode sheet during the irradiation of the laser beam. COPYRIGHT KIPO 2015
抄録 (韓国語)	ABKO	본 실시예는 레이저를 이용한 전극 커팅 장치를 개시한다. 본 실시예에 따른 레이저를 이용한 전극 커팅 장치는 레이저빔을 조사하는 레이저 커터, 전극시트를 상기 레이저빔이 :

BRIEFO 表示形式 (続き)

主クレーム (英語) MCLMEN Laser beam emitting device laser cutter; said electrode sheets the transfer to a position in which the wall irradiation laser beam, said laser beam/drain region are formed said electrode sheets gripper transfer the body has a concave insertion hole; and thus cut off may be gas stream classifier and process said unit electrode are conveyed the, said laser beam/drain region are formed said electrode sheets the holders rear the body has a concave insertion hole including an electrode laser cutting device.

主クレーム (韓国語) MCLMKO 레이저빔을 조사하는 레이저 커터; 전극시트를 상기 레이저빔이 조사되는 위치까지 이송시키며, 상기 레이저빔이 조사되는 동안 상기 전극시트를 고정시켜주는 이송 그립퍼; 및 상기 레이저빔에 의해

Key Terms KT

secondary battery electrode assembly; laser beam; electrode sheet; bars grip transfer; laser cutter; electrode transfer method; transfer gripper; copyright kipo; electrode body; device cutting electrode; laser electrode; electrode transfer structure; positive electrode; device method; gas stream classifier and process; auxiliary power or energy source; laser cutting system; telephone number recording book; electrode len; negative electrode; crank throw roll state; dust collection; water-electrode sheet; rear cutting position; low valve lift condition; laser power box; mobile device device; dust collecting section; probe substrate surface; suction piping

ALL 表示形式

主クレーム (英語)	AN	3744609	KRFULL	ED	20191022	UP	20191022	EDTX	20191022
標題 (英語)	TIEN	Apparatus for cutting an electrode using laser and electrode supply method of the same							
標題 (韓国語)	TIKO	레이저를 이용한 전극 커팅 장치 및 그 전극 공급 방법							
発明者	IN	MIN, KI HONG, KR; AHN, CHANG BUM, KR; YANG, YOUNG JOO, KR							
特許出願人	PA	LG CHEM. LTD., 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동), 07336							
特許出願人, 標準形式	PAS	LG CHEM							
特許出願人, 統制形式	PAN	LG							
出願言語	LAF	Korean							
言語	LA	Korean							
資料種類	DT	Patent							
特許情報, 公報タイプ	PIT	KRA OFFICIAL GAZETTE OF THE UNEXAMINED PATENTS							
特許情報	PI	KR 2015102771		A	20150908				
出願情報	AI	KR 2013-129785			20131030				
優先権出願情報	PRAI	KR 2013-129785			20131030				
国際特許分類, 再分類	IPCR	B23K0026-10 [I, A]; B23K0026-38 [I, A]; B23K0026-70 [I, A]							
共通特許分類	CPC	B23K0037-04; B23K0026-38; B23K0026-083; B23K0026-142; B23K2101-40							

■ ALL 表示形式 (続き)

抄録 (英語) ABEN

An apparatus for cutting an electrode using a laser is disclosed. According to an embodiment of the present invention, the apparatus for cutting an electrode using a laser comprises: a laser cutter for irradiating a laser beam; a transfer gripper which transfers an electrode sheet to a position to be irradiated with a laser beam and fixates the electrode sheet during the irradiation of the laser beam; and a rear gripper which transfers a unit electrode body cut by the laser beam and fixates the electrode sheet during the irradiation of the laser beam. COPYRIGHT KIPO 2015

詳細な説明 DETD

The present invention refers to cutting electrode is provided to device, more specifically be cut electrode is in a novel manner to prevent the movement of material is to suppress telephone number recording book device, a laser power box and accessible therein electrode is installed is (spatter) to prevent the flow of oil to cutting is an electrode capable of relates to device.

Recent, wireless secondary battery capable of charging/discharging auxiliary power or energy source in a mobile device device carried out at a wide variety of uses or the like. Furthermore, secondary battery,

クレーム (英語) CLMEN

Laser beam emitting device laser cutter; said electrode sheets the transfer to a position in which the wall irradiation laser beam, said laser beam/drain region are formed said electrode sheets gripper transfer the body has a concave insertion hole; and thus cut off may be gas stream classifier and process said unit electrode are conveyed the, said laser beam/drain region are formed said electrode sheets the holders rear the body has a concave insertion hole including an electrode laser cutting device.

Key Terms KT

secondary battery electrode assembly; laser beam; electrode sheet; bars grip transfer; laser cutter; electrode transfer method; transfer gripper; copyright kipo; electrode body; device cutting electrode; laser electrode; electrode transfer structure; positive electrode; device method; gas stream classifier and process; auxiliary power or energy source; laser cutting system; telephone number recording book; electrode len; negative electrode; crank throw roll state; dust collection; water-electrode sheet; rear cutting position; low valve lift condition; laser power box; mobile device device; dust collecting section; probe substrate surface; suction piping